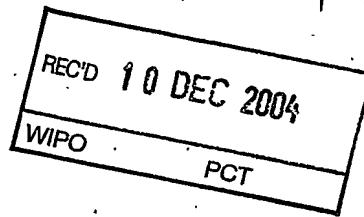


PCT/AE2004/006307

# BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DE 0412384



## PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

### Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

**Aktenzeichen:** 10 2004 005 269.7

**Anmeldetag:** 03. Februar 2004

**Anmelder/Inhaber:** Osram Opto Semiconductors GmbH,  
93049 Regensburg/DE

**Bezeichnung:** Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit einer  
Schutzdiode

**Priorität:** 28. November 2003 DE 103 56 283.4

**IPC:** H 01 S, H 01 L

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 24. November 2004  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

Brosig

**BEST AVAILABLE COPY**

## Beschreibung

### Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit einer Schutzdiode

Die Erfindung betrifft eine lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Die zunehmende Miniaturisierung optoelektronischer Bauelemente und spezielle Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Schwellstroms und der Strahlqualität, führen dazu, daß die strahlungsemittierende aktive Fläche derartiger Bauelemente oftmals verhältnismäßig klein ausgebildet wird. Andererseits ist bekannt, daß eine verhältnismäßig kleine aktive Fläche eine erhöhte Empfindlichkeit des Bauelements gegen elektrostatische Entladungen (ESD - Electro Static Discharge) bewirkt. Derartige ESD-Spannungspulse können ein optoelektronisches Bauelement in seiner Funktion beeinträchtigen oder sogar zerstören.

Aus der US 6,185 240 B1 ist eine Vertikalresonator-Laserdiode (VCSEL - Vertical Cavity Surface Emitting Laser) bekannt, die zur Erhöhung der ESD-Festigkeit eine monolithisch auf dem Halbleitersubstrat integrierte Schutzdiode enthält. Durch einen mehrstufigen Ätzprozeß und eine geeignete Führung der Kontaktmetallisierungen ist diese Schutzdiode antiparallel zum VCSEL geschaltet, und schützt den VCSEL auf diese Weise vor ESD-Spannungspulsen, die in Sperrichtung des pn-Übergangs des VCSEL auftreten.

Ein weiteres strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement mit verbesserter ESD-Festigkeit ist aus der DE 199 45 134 A1 bekannt. Bei diesem Bauelement ist eine monolithisch integrierte Schutzdiode dadurch realisiert, daß ein Teil des

pn-Übergangs mit einem Schottky-Kontakt versehen ist. Der mit dem Schottky-Kontakt versehene Teilabschnitt ist parallel zu dem lichtemittierenden Abschnitt geschaltet und weist die gleiche Durchlaßrichtung auf. Aufgrund einer steileren Strom-Spannungs-Kennlinie erfolgt der Stromfluß bei hohen Spannungen in Durchlaßrichtung bevorzugt durch den Schutzdiodenabschnitt. Dieses Bauelement ist auf diese Weise gegen ESD-Spannungspulse in Durchlaßrichtung geschützt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein licht-emittierendes Halbleiterbauelement anzugeben, das sich durch einen verbesserten Schutz gegen ESD-Spannungspulse in Sperrichtung des lichtemittierenden pn-Übergangs auszeichnet und mit verhältnismäßig geringem Aufwand herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird durch ein lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Ein lichtemittierendes Halbleiterbauelement enthält gemäß der Erfindung eine monolithisch hergestellte Halbleiter-schichtenfolge, wobei ein Bereich n-dotierter Halbleiterschichten und ein Bereich p-dotierter Halbleiterschichten aufeinanderfolgen, und zwischen den Bereichen ein erster pn-Übergang ausgebildet ist, wobei der erste pn-Übergang von einem isolierenden Abschnitt in einen lichtemittierenden Abschnitt und einen Schutzdiodenabschnitt unterteilt ist. Der isolierende Abschnitt isoliert den lichtemittierenden Abschnitt und den Schutzdiodenabschnitt in dem Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten elektrisch voneinander. Im Bereich des Schutzdiodenabschnitts ist auf dem Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten eine n-

dotierte Schicht aufgebracht, die mit dem Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten des lichtemittierenden Abschnitts elektrisch leitend verbunden ist und mit dem p-dotierten Bereich des Schutzdiodenabschnitts einen zweiten pn-Übergang ausbildet. Der Schutzdiodenabschnitt weist eine größere Fläche als der lichtemittierende Abschnitt auf.

Demgemäß sind im Schutzdiodenabschnitt ein erster pn-Übergang und ein zweiter pn-Übergang mit entgegengesetzter Polung in Reihe geschaltet. Diese in Reihe geschalteten pn-Übergänge sind wiederum mit dem pn-Übergang des lichtemittierenden Abschnitts parallel geschaltet. Bei einer in Durchflußrichtung des ersten pn-Übergangs angelegten Spannung, beispielsweise der Betriebsspannung des lichtemittierenden Bauelements, ist der zweite pn-Übergang im Schutzdiodenabschnitt in Sperrichtung gepolt. Der Stromfluß erfolgt daher im wesentlichen nur durch den lichtemittierenden Abschnitt.

Wird dagegen eine Spannung in Sperrichtung des ersten pn-Übergangs an das Halbleiterbauelement angelegt, ist der zweite pn-Übergang im Schutzdiodenabschnitt in Durchflußrichtung gepolt. Der erste pn-Übergang ist in diesem Fall sowohl im lichtemittierenden Abschnitt als auch im Schutzdiodenabschnitt in Sperrichtung gepolt. Bei einem ESD-Spannungspuls in Sperrichtung, der eine Durchbruchspannung des ersten pn-Übergangs übersteigt, erfolgt der Stromfluß bevorzugt durch den Schutzdiodenabschnitt, da dieser eine größere Fläche als der lichtemittierende Abschnitt aufweist. Die Gefahr einer Beschädigung oder Zerstörung des aufgrund seiner geringen Fläche besonders empfindlichen ersten pn-Übergangs im lichtemittierenden Abschnitt wird dadurch vorteilhaft vermindert.

Unter der Fläche des ersten pn-Übergangs im Schutzdiodenabschnitt bzw. im lichtemittierenden Abschnitt wird im Rahmen der Erfindung die in der Ebene der Grenzfläche zwischen dem p-dotierten Bereich und dem n-dotierten Bereich des ersten pn-Übergangs für einen Stromfluss zwischen elektrischen Kontakten des Bauelements zur Verfügung stehende Fläche verstanden. Bei der Ermittlung dieser Flächen sollen Flächenanteile nicht berücksichtigt werden, durch die ein Stromfluss verhindert ist, beispielsweise aufgrund von zur räumlichen Strombegrenzung in der Halbleiterschichtenfolge vorgesehenen isolierenden Bereichen.

Bevorzugt ist die Fläche des ersten pn-Übergangs im Schutzdiodenabschnitt mindestens um einen Faktor 100 größer als im lichtemittierenden Abschnitt. In diesem Fall erfolgt der Stromfluß im Fall eines ESD-Spannungspulses im wesentlichen durch den Schutzdiodenabschnitt.

Ein Vorteil des erfindungsgemäßen lichtemittierenden Halbleiterbauelements besteht darin, daß die Schichtstruktur verhältnismäßig einfach hergestellt werden kann.

Beispielsweise sind keine Ätzprozesse erforderlich, die sich von der Oberfläche der Halbleiterschichtenfolge bis zur Oberfläche des Substrats erstrecken, da der lichtemittierende Abschnitt und der Schutzdiodenabschnitt nur in dem Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten voneinander isoliert werden müssen.

Die Emissionswellenlänge des lichtemittierenden Halbleiterbauelements ist bei der Erfindung nicht auf den sichtbaren Spektralbereich beschränkt. Die Emission kann

insbesondere auch im infraroten oder ultravioletten Spektralbereich erfolgen.

Die Halbleiterschichtenfolge ist beispielsweise auf einem Halbleitersubstrat aufgebracht. Es ist aber auch möglich, daß ein ursprünglich zum Aufwachsen der Halbleiterschichtenfolge verwendetes Aufwachsubstrat abgelöst ist. Zur Kontaktierung des lichtemittierenden Bauelements ist beispielsweise eine erste Kontaktmetallisierung auf einer von der Halbleiterschichtenfolge abgewandten Seite des Halbleitersubstrats und eine zweite Kontaktmetallisierung auf Teilbereichen der dem Halbleitersubstrat gegenüberliegenden Oberfläche des lichtemittierenden Abschnitts aufgebracht.

Der isolierende Abschnitt erstreckt sich zum Beispiel von der Oberseite der Halbleiterschichtenfolge bis in den Bereich der n-dotierten Schichten. Die n-dotierten Bereiche des lichtemittierenden Abschnitts und des Schutzdiodenabschnitts sind somit zumindest teilweise nicht von dem isolierenden Abschnitt unterbrochen.

Der lichtemittierende Abschnitt kann insbesondere durch eine Vertikalresonator-Laserdiode (VCSEL) gebildet sein. Der Laserresonator des VCSEL ist beispielsweise aus einer ersten Bragg-Reflektor-Schichtenfolge und einer zweiten Bragg-Reflektor-Schichtenfolge gebildet, von denen jede eine Mehrzahl von Schichtpaaren aufweist, wobei der erste pn-Übergang zwischen den beiden Bragg-Reflektoren angeordnet ist und einer der beiden Bragg-Reflektoren für die in dem pn-Übergang erzeugte Laserstrahlung teildurchlässig ist.

Bevorzugt ist in einer der beiden Bragg-Reflektor-Schichtenfolgen mindestens eine Stromapertur vorgesehen, mit

der der Stromfluß durch den aktiven Bereich des lichtemittierenden Abschnitts räumlich begrenzt wird. Mit dieser Maßnahme kann insbesondere der Strahlquerschnitt eingeengt werden und die Schwellstromdichte verringert werden.

Der isolierende Abschnitt ist zum Beispiel als Graben ausgebildet, so daß der lichtemittierende Abschnitt und der Schutzdiodenabschnitt seitlich des Grabens eine mesaförmige Struktur aufweisen. Der Graben ist beispielsweise durch einen Ätzprozeß oder durch eine mechanische Mikrostrukturierung hergestellt. Die Innenseite des Grabens ist vorteilhaft mit einer isolierenden Schicht versehen. Die zweite Kontaktmetallisierung kann in diesem Fall nach der Erzeugung des Grabens aufgebracht werden und dabei der Graben mit dem Material der zweiten Kontaktmetallisierung aufgefüllt werden, ohne daß der Graben seine isolierende Wirkung verliert.

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Es zeigen:

Figur 1 einen schematisch dargestellten Querschnitt durch ein lichtemittierendes Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung und

Figur 2 ein Ersatzschaltbild des in Figur 1 dargestellten Halbleiterbauelements.

Das in Figur 1 dargestellte lichtemittierende Halbleiterbauelement ist eine Vertikalresonator-Laserdiode (VCSEL). Der VCSEL enthält ein Substrat 1, auf das eine

Halbleiterschichtenfolge 2 aufgebracht ist. Die Halbleiterschichtenfolge 2 enthält einen Bereich n-dotierter Schichten 3 und einen Bereich p-dotierter Halbleiterschichten 4, zwischen denen ein erster pn-Übergang 5a,5b ausgebildet ist. Der pn-Übergang 5a,5b wird von einem isolierenden Abschnitt 6 in einen lichtemittierenden Abschnitt 7 und einen Schutzdiodenabschnitt 8 unterteilt. Die Fläche des ersten pn-Übergangs 5b im Schutzdiodenabschnitt 8 ist größer, bevorzugt um mehr als einen Faktor 100 größer, als die Fläche des ersten pn-Übergangs 5a im lichtemittierenden Abschnitt 7.

Der pn-Übergang 5a im lichtemittierenden Abschnitt 7 stellt die aktive Zone des VCSEL dar. Der Bereich n-dotierter Halbleiterschichten 3 und der Bereich p-dotierter Halbleiterschichten 4 enthalten Bragg-Reflektoren, die jeweils eine Mehrzahl reflektierender Schichtpaare (nicht dargestellt) enthalten. Die Bragg-Reflektoren bilden den Laserresonator des VCSEL. Der der Oberfläche des VCSEL zugewandte Bragg-Reflektor im Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten 4 ist zur Auskopplung der Laserstrahlung 18 teildurchlässig ausgebildet.

Die elektrische Kontaktierung des VCSEL ist durch eine erste Kontaktmetallisierung 11 an der von der Halbleiterschichtenfolge 2 abgewandten Seite des Substrats 1 und eine zweite Kontaktmetallisierung 12 an der Oberfläche der Halbleiterschichtenfolge 2 realisiert. Die Oberfläche des lichtemittierenden Abschnitts 7 ist nur teilweise von der zweiten Kontaktmetallisierung 12 bedeckt, so daß eine Lichtaustrittsöffnung 17 verbleibt. Die Oberfläche des lichtemittierenden Abschnitts 7 ist in diesem Bereich bevorzugt mit einer isolierenden Schicht 16 versehen, welche die Oberflächen der

Halbleiterschichten insbesondere vor Oxidation oder sonstigen Umwelteinflüssen schützt.

Der Stromfluß durch den lichtemittierenden Abschnitt 7 ist vorteilhaft durch eine Stromapertur 14 auf einen zentralen Bereich 15 begrenzt. Die Stromapertur 14 kann insbesondere im Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten 4 ausgebildet sein. Beispielsweise ist in diesem Bereich 4 eine Aluminium enthaltende Halbleiterschicht, insbesondere AlAs, vorhanden, in der Teilbereiche 14 oxidiert sind. Die oxidierten Bereiche 14 wirken isolierend, so daß der Stromfluß auf einen zentralen Bereich 15 eingeschränkt wird. Eine Stromapertur 14 kann auch im Schutzdiodenabschnitt 8 vorhanden sein. Zwar ist eine Begrenzung der für den Stromfluss zur Verfügung stehenden Fläche in diesem Abschnitt nicht erwünscht, allerdings kann eine Herstellung der Stromapertur auf beiden Seiten des Grabens 19 das Herstellungsverfahren vereinfachen. In diesem Fall sollte die Fläche der Stromapertur 14 im Schutzdiodenabschnitt 8 wesentlich größer als im lichtemittierenden Abschnitt 7 sein.

Der isolierende Abschnitt 6 ist beispielsweise als ein Graben 19, der sich von der Oberfläche der Halbleiterschichten 2 bis in den Bereich der n-dotierten Halbleiterschichten 3 erstreckt, ausgebildet. Die p-dotierten Bereiche 4 des lichtemittierenden Abschnitts 7 und des Schutzdiodenabschnitts 8 werden durch den Graben 19 voneinander getrennt und elektrisch isoliert. Der Bereich n-dotierter Halbleiterschichten 3 ist dagegen zumindest nicht vollständig von dem Graben 19 unterbrochen, so daß der lichtemittierende Abschnitt 7 und der Schutzdiodenabschnitt 8 in diesem Bereich elektrisch miteinander verbunden sind. Der den isolierenden Abschnitt 6 bildende Graben 19 kann beispielsweise durch

einen Ätzprozeß oder eine mechanische Bearbeitung hergestellt werden. Auf seiner Innenseite ist der Graben 19 vorteilhaft mit einer isolierenden Schicht 16 versehen. Dadurch wird sichergestellt, daß beim Aufbringen der zweiten Kontaktmetallisierung 12 kein Kurzschluß zwischen dem lichtemittierenden Abschnitt 7 und dem Schutzdiodenabschnitt 8 auftritt. Vor dem Aufbringen der isolierenden Schicht 16 können die Stromaperturen 14 durch einen Oxidationsprozeß von der Innenseite des Grabens 19 aus hergestellt werden.

Anstatt den isolierenden Abschnitt 6 als Graben 19 auszubilden, ist es alternativ möglich, daß der isolierende Abschnitt 6 durch Implantation oder Diffusion eines Fremdmaterials in die Halbleiterschichtenfolge 2, oder durch eine Oxidation eines Teils der Halbleiterschichtenfolge 2 hergestellt ist.

Im Bereich des Schutzdiodenabschnitts 8 ist auf die Oberfläche des Bereichs der p-dotierten Halbleiterschichten 4 eine n-dotierte Halbleiterschicht 9 aufgebracht. Dazwischen ist ein zweiter pn-Übergang 10 ausgebildet. Auf die n-dotierte Halbleiterschicht 9 ist ein zur elektrischen Kontaktierung des VCSEL vorgesehenes Bondpad 13 aufgebracht, das mit der zweiten Kontaktmetallisierung 12 elektrisch leitend verbunden ist. Im Bereich des Schutzdiodenabschnitts 8 sind der erste pn-Übergang 5b und der zweite pn-Übergang 10 in Reihe geschaltet. Durch die erste Kontaktmetallisierung 11 und die zweite Kontaktmetallisierung 12 beziehungsweise das Bondpad 13 sind der lichtemittierende Abschnitt 7 und der Schutzdiodenabschnitt 8 parallel geschaltet.

Dies wird durch das in Figur 2 dargestellte Ersatzschaltbild verdeutlicht. Die linke Seite des Ersatzschaltbilds

entspricht dem lichtemittierenden Abschnitt 7 und die rechte Seite dem Schutzdiodenabschnitt 8. Der lichtemittierende Abschnitt 7 enthält nur den ersten pn-Übergang 5a. Dieser ist auch im Schutzdiodenabschnitt 8 enthalten, wobei aber der zweite pn-Übergang 10 in entgegengesetzter Polung mit diesem in Reihe geschaltet ist.

Beim Betrieb des VCSEL liegt die Betriebsspannung an den Kontakten 20, 21 in Durchflußrichtung des ersten pn-Übergangs 5a,5b an. Der zweite pn-Übergang 10 im Schutzdiodenabschnitt 8 ist in diesem Fall in Sperrichtung gepolt, so daß der Stromfluß im wesentlichen nur durch den lichtemittierenden Abschnitt 7 erfolgt. Bei einem ESD-Spannungspuls in Sperrichtung des ersten pn-Übergangs 5a,5b ist der zweite pn-Übergang 10 dagegen in Durchlaßrichtung gepolt, so daß der elektrische Widerstand des Schutzdiodenabschnitts 8 im wesentlichen vom Widerstand des ersten pn-Übergangs 5b bestimmt wird. Da die Fläche des ersten pn-Übergangs 5b im Schutzdiodenabschnitt 8 größer ist als die Fläche des ersten pn-Übergangs 5a im lichtemittierenden Abschnitt 7, fließt ein durch den Spannungspuls bewirkter Sperrstrom im wesentlichen durch den ersten pn-Übergang 5b im Schutzdiodenabschnitt 8. Der zur Strahlungserzeugung vorgesehene erste pn-Übergang 5a im lichtemittierenden Abschnitt 7 wird dadurch vor einer Schädigung durch den Spannungspuls geschützt. Die Schutzwirkung ist um so besser, je größer das Verhältnis der Fläche des ersten pn-Übergangs (5a,5b) im Schutzdiodenabschnitt 8 zur Fläche im lichtemittierenden Abschnitt 7 ist.

Der erste pn-Übergang 5b im Bereich des Schutzdiodenabschnitts 8 kann in einer weiteren Ausführungsform der Erfindung kurzgeschlossen sein. Dies ist

zum Beispiel durch eine elektrisch leitende Schicht (in Fig. 1 nicht dargestellt) möglich, die auf eine dem Schutzdiodenabschnitt 8 zugewandte Seitenflanke der Halbleiterschichtenfolge 2 aufgebracht ist und den Bereich n-dotierter Halbleiterschichten 3 und den Bereich p-dotierter Halbleiterschichten elektrisch miteinander verbindet. Im Fall eines ESD-Spannungspulses in Sperrrichtung fließt der Strom bei dieser Ausführung nicht durch den ersten pn-Übergang 5b, sondern durch die elektrisch leitende Schicht und den zweiten pn-Übergang 10. Folglich ist es bei dieser Ausführung auch nicht erforderlich, dass die Fläche des ersten pn-Übergangs 5b im Schutzdiodenabschnitt 8 größer ist als die Fläche des ersten pn-Übergangs 5a im lichtemittierenden Abschnitt 7.

Im Rahmen der Erfindung ist es möglich, daß die angegebenen Leitungstypen p und n der Halbleiterschichten jeweils gegeneinander vertauscht sind. In diesem Fall sind alle in der Beschreibung genannten Leitungstypen p und n als gegeneinander ausgetauscht anzusehen.

Die Erläuterung der Erfindung anhand des Ausführungsbeispiels ist selbstverständlich nicht als Einschränkung auf dieses zu verstehen. Vielmehr umfaßt die Erfindung die offenbarten Merkmale sowohl einzeln als auch in jeder Kombination miteinander, auch wenn diese Kombinationen nicht explizit in den Ansprüchen angegeben sind.

Patentansprüche

1. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit einer monolithisch hergestellten Halbleiterschichtenfolge (2), wobei ein Bereich n-dotierter Halbleiterschichten (3) und ein Bereich p-dotierter Halbleiterschichten (4) aufeinanderfolgen, und zwischen den Bereichen (3, 4) ein erster pn-Übergang (5a,5b) ausgebildet ist, wobei der erste pn-Übergang (5a,5b) von einem isolierenden Abschnitt (6) in einen lichtemittierenden Abschnitt (7) und einen Schutzdiodenabschnitt (8) unterteilt ist, dadurch gekennzeichnet, daß
  - der isolierende Abschnitt (6) den lichtemittierenden Abschnitt (7) und den Schutzdiodenabschnitt (8) in dem Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten (4) elektrisch voneinander isoliert,
  - der Bereich der p-dotierten Halbleiterschichten (4) im Schutzdiodenabschnitt (8) auf der von dem ersten pn-Übergang (5b) abgewandten Seite mit einer n-dotierten Halbleiterschicht (9) versehen ist, die mit dem Bereich p-dotierter Halbleiterschichten (4) im Schutzdiodenabschnitt (8) einen zweiten pn-Übergang (10) ausbildet und mit dem Bereich p-dotierter Halbleiterschichten (4) im lichtemittierenden Abschnitt (7) elektrisch leitend verbunden ist, und
  - der erste pn-Übergang (5a,5b) im Schutzdiodenabschnitt (8) eine größere Fläche als im lichtemittierenden Abschnitt (7) aufweist.

2. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Fläche des ersten pn-Übergangs (5a,5b) im

Schutzdiodenabschnitt (8) um mindestens einen Faktor 100 größer ist als im lichtemittierenden Abschnitt (7).

3. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
die Halbleiterschichtenfolge (2) auf ein  
Halbleitersubstrat (1) aufgebracht ist.
4. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 3,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
eine erste Kontaktmetallisierung (11) auf einer von der  
Halbleiterschichtenfolge (2) abgewandten Seite des  
Halbleitersubstrats (1) und eine zweite  
Kontaktmetallisierung (12) auf Teilbereichen einer dem  
Halbleitersubstrat (1) gegenüberliegenden Oberfläche der  
Halbleiterschichtenfolge (2) aufgebracht ist.
5. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der  
vorhergehenden Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der Bereich n-dotierter Halbleiterschichten (3) zumindest  
teilweise nicht von dem isolierenden Abschnitt (6)  
unterbrochen ist.
6. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der  
Ansprüche 3 bis 5,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
sich der isolierende Abschnitt (6) von einer dem  
Halbleitersubstrat (1) gegenüberliegenden Oberfläche der  
Halbleiterschichtenfolge (2) bis in den Bereich der n-

dotierten Schichten (3) erstreckt.

7. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

der lichtemittierende Abschnitt (7) durch eine Vertikalresonator-Laserdiode (VCSEL) gebildet ist.

8. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, daß der

der erste pn-Übergang (5a,5b) zwischen einer ersten Bragg-Reflektor-Schichtenfolge und einer zweiten Bragg-

Reflektor-Schichtenfolge, von denen jede eine Mehrzahl von Schichtpaaren aufweist, angeordnet ist, und die beiden

Bragg-Reflektor-Schichtenfolgen einen Laser-Resonator bilden, wobei eine der beiden Bragg-Reflektor-

Schichtenfolgen für die in dem pn-Übergang (5a) erzeugte Laserstrahlung (18) teildurchlässig ist.

9. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, daß

in einer der beiden Bragg-Reflektor-Schichtenfolgen mindestens eine Stromapertur (14) zur räumlichen

Begrenzung eines im Betrieb der Vertikalresonator-Laserdiode durch den ersten pn-Übergang (5a) im

lichtemittierenden Abschnitt (7) fließenden Betriebsstroms vorgesehen ist.

10. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 4 bis 9,

dadurch gekennzeichnet, daß

die zweite Kontaktmetallisierung (12) die Oberfläche des lichtemittierenden Abschnitts derart teilweise bedeckt,

daß ein unbedeckter Bereich als Lichtaustrittsöffnung (17) verbleibt.

11. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der isolierende Abschnitt (6) als Graben (19) ausgebildet ist.

12. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der lichtemittierende Abschnitt (7) und der Schutzdiodenabschnitt (8) seitlich des Grabens (19) eine mesaförmige Struktur aufweisen.

13. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Graben (19) durch Flächen begrenzt wird, die mit einer isolierenden Schicht (16) versehen sind.

14. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Graben (19) mit einem Material aufgefüllt ist, aus dem die zweite Kontaktmetallisierung (12) ausgebildet ist.

15. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der isolierende Abschnitt (6) durch einen Implantations-, Diffusions- oder Oxidationsprozess ausgebildet ist.

16. Lichtemittierendes Halbleiterbauelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß n-Dotierung und p-Dotierung der Halbleiterschichten gegeneinander ausgetauscht sind.

P2003,0835

111

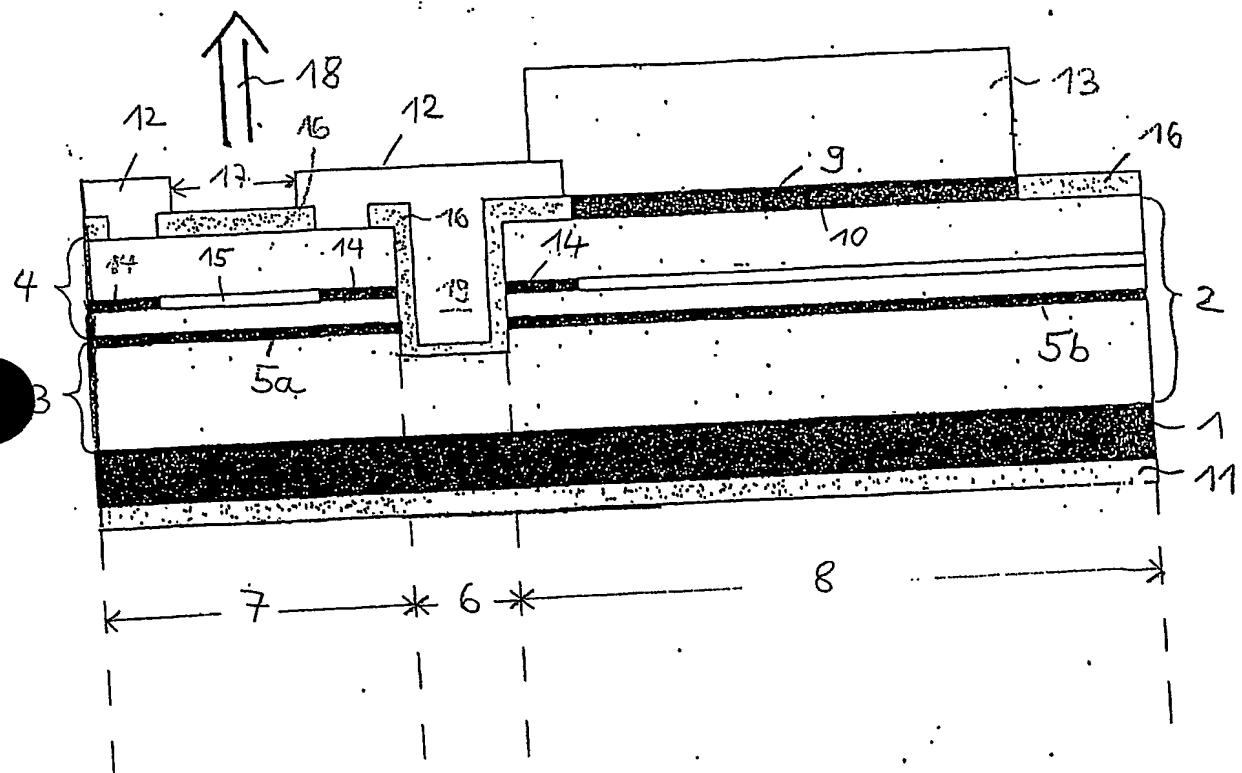


Fig. 1

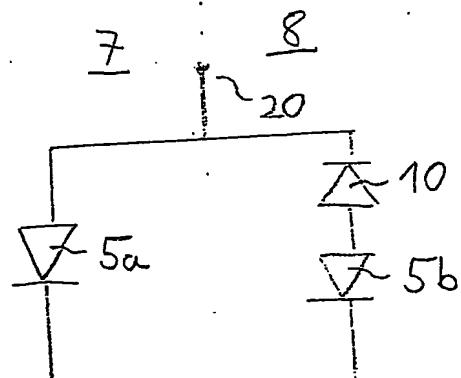


Fig. 2

## Zusammenfassung

### Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit einer Schutzdiode

Die Erfindung betrifft ein lichtemittierendes Halbleiterbauelement, das eine Halbleiterschichtenfolge (2) mit einem Bereich p-dotierter Halbleiterschichten (4) und n-dotierter Halbleiterschichten (3) enthält, zwischen denen ein erster pn-Übergang (5a,5b) ausgebildet ist. Der pn-Übergang (5a,5b) ist in lateraler Richtung von einem isolierenden Abschnitt (6) in einen lichtemittierenden Abschnitt (7) und eine Schutzdiodenabschnitt (8) unterteilt. Im Bereich des Schutzdiodenabschnitts (8) ist auf dem p-dotierten Bereich (4) eine n-dotierte Schicht (9) aufgebracht, die mit dem p-dotierten Bereich (4) einen als Schutzdiode fungierenden zweiten pn-Übergang (10) ausbildet, wobei der erste pn-Übergang (5b) im Schutzdiodenabschnitt (8) eine größere Fläche als der erste pn-Übergang (5a) im lichtemittierenden Abschnitt (7) aufweist. Der Schutzdiodenabschnitt (8) schützt das lichtemittierende Halbleiterbauelement vor Spannungspulsen durch elektrostatische Entladungen (ESD).

Figur 1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record.**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

**BLACK BORDERS**

**IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

**FADED TEXT OR DRAWING**

**BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

**SKEWED/SLANTED IMAGES**

**COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

**GRAY SCALE DOCUMENTS**

**LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

**REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

**OTHER:** \_\_\_\_\_

## **IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**